

## **ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ**

на диссертацию Федина Ивана Владимировича

“Мощные быстродействующие диоды на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия”,  
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.04.04 – физическая электроника

Федин И.В. поступил в ТУСУР на кафедру физической электроники в 2009 г. В 2013 г. с отличием окончил обучение в бакалавриате по специальности «Нанотехнологии». В 2015 г. с отличием окончил магистерскую программу «Электроника и наноэлектроника» и поступил в очную аспирантуру на кафедре ФЭ. Работу над диссертацией он совмещал с участием в выполнении федеральных целевых программ “Разработка технологии изготовления силовых коммутационных транзисторов на основе нитрида галлия для создания энергоэффективных источников вторичного электропитания” и “Разработка перспективных однокристалльных передающих СВЧ модулей миллиметрового диапазона на основе полупроводников типа  $A_3B_5$  для применения в современных информационно-коммуникационных системах нового поколения (5G)”.

Во время обучения в ВУЗе и выполнения научных исследований Федин И.В. проявлял настойчивость, целеустремлённость и инициативу. Поставленные задачи решались качественно и в срок.

Во время обучения в аспирантуре подход Федина И.В. к обучению и исследовательской деятельности не изменился. Он проявил себя самостоятельным квалифицированным исследователем, способным ставить и решать сложные научно-технические задачи. Об успехах научно-исследовательской работы соискателя говорят 22 опубликованные работы, 5 из которых изданы в журналах из перечня ВАК, 6 проиндексированы в базе данных Scopus.

Наряду с научно-исследовательской работой Федин И.В. занимался педагогической деятельностью. Под руководством соискателя была защищена магистерская диссертация Пушкарёвой К.В., а так же различные производственные практики, выполненные в НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУР.

